日本新电元（ShinDengen）公司推出了一款高性能N沟道YYY——XXX，

XXX是新电元（ShinDengen）公司推出的一款针对工业化应用的N沟道YYY，

XXX是日本新电元公司推出的一款工业级N沟道YYY，

新电元（ShinDengen）公司一直致力于功率电子领域，近日推出了一款N沟道YYY——XXX，

XXX是新电元公司推出的一款性能优异的面向开关电源的N沟道YYY，

Shindengen（新电元）半导体公司推出了一款型号XXX适用于开关电源的N沟道YYY，

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

相对于P沟道MOS管，导通电阻更小，并且容易制造。

相比于P沟道MOS管，拥有更小的导通电阻。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

金属氧化物半导体场效应管

MOSFET

金属氧化物场效应晶体管

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

最大漏极/源极电压VDSS（雪崩击穿电压）为XXXV，最大漏极持续电流（DC）Id为YYYA，

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

是极有发展前途的电力、电子半导体器件。

所用的框架和引脚采用无缝焊接技术锻造而成，拥有更好的包封和阻燃性能。

性能稳定可靠，是设计中大功率开关电源的理想选择。

体积小巧同时适合大规模批量生产，是中大功率电源类应用的理想选择。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

可应用于XXX等应用。

广泛使用于XXX等应用。

主要面向XXX等市场应用。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

采用SMD（Surface Mounted Devices）表面贴装，以Sn为主要材料，大多采用内箱直径为180mm的Tape & Reel带卷式封装。

采用THD插装式封装，接线板以Sn为主要材料。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

具体封装形态为XXX，是一款

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

高耐压Hi-Pot型MOS，由于采用了全检模式，是业界唯一能保证DI/DT的厂商，导通电阻降低了至少20%。

CoolMos型MOS，是一种经济性备选方案，能在某些耗散功率较低的设计中节省空间。

低Rds(on) EET型MOS，应用trench-gate结构优化布局，降低了Qg、Rds(on)等，同时100%使用di/dt雪崩测试来筛选产品。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

尺寸为XXXmm，适用于小型嵌入式电器设计。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXX的最大栅极/源极电压VGSS为YYYV，最大耗散功率Pd为ZZZW，提高了能源利用效率，同时保障了MOSFET在高功率场合下的可靠性和稳定性。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

其静态漏源导通电阻Rds典型值为XXXΩ，最高沟道温度Tch为YYY℃，总栅极电荷量典型值Qg为ZZZ nC。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

图一：XXX外部视图

图二：XXX典型输出特性及转移特性曲线

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~Tc = 25℃时，当漏极电流Id为10A，栅极电压VGS为10V时，其静态漏源导通电阻Rds(on)典型值为 mΩ，最大值为 mΩ，拥有较低的损耗，可减少自身发热。最大结壳热阻θjc为 ℃/Ｗ。上升时间和下降时间典型值分别为10ns和13ns ，开关作用迅速。~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

具有等特点。

4.5V栅极驱动

，具有低电容的特点。

低电容、低静态导通电阻

大电流的特点

高电压

高雪崩耐久性、高di/dt耐久性等优点

低噪声

高切换速度

高电流

绝缘封装

最大漏极/源极电压VDSS（雪崩击穿电压）为XXXV，最大栅极/源极电压VGSS为YYYV

最大漏极持续电流（DC）Id为YYYA，最大耗散功率Pd为ZZZW

静态漏源导通电阻Rds典型值为XXXΩ

最高沟道温度Tch为YYY℃

总栅极电荷量典型值Qg为ZZZ nC

采用XXX封装, 尺寸大小为YYY

mosfet特性

1、场效应晶体管是电压控制元件，而双极结型晶体管是电流控制元件。在只允许从取较少电流的情况下，应选用场效应管；

2、有些场效应管的源极和漏极可以互换使用，栅压也可正可负，灵活性比双极晶体管好。

3、场效应管是利用多数载流子导电，所以称之为单极型器件。

4、场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作，而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上，因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。

mosfet应用

除了传统上应用于诸如微处理器、微控制器等数位信号处理的场合上，也有越来越多模拟信号处理的集成电路可以用MOSFET来实现。

●分布式电源架构

●汽车电源

●高密度

●电信系统

连接方式：电源输入正极连接到D极，由S极输出；驱动电压的正加在G极，驱动电压的负加在S极。

G极电压必须大于S极才能导通工作，如果S极连接到地电位，可以直接驱动

最大额定功耗Pt为 ，提高了能源利用效率。

采用SMD封装

SMD（Surface Mounted Devices）表面贴装器件领域，而SMD又属于SMT(Surface Mount Technology）元器件中的一种，大部分引脚元件都采用这种封装技术，具体来说，M1F封装接线板是以Sn为主要材料，大多采用内箱直径为180mm的Tape & Reel带卷式封装

THD封装是一种插装式封装，接线板是以Sn为主要材料。

用户可根据实际功率电路的电流大小选择合适的型号。

更高的最大耗散功率不仅扩展了管子的应用范围，还可以保障MOSFET在高功率场合下的可靠性和稳定性

图一：P20FH50HP2外部视图

图二：P20B12SN典型输出特性及转移特性曲线

在开关电源应用中，低MOS管导通电阻可以保持自身的低损耗和低发热，同时低栅极电荷和高开/关速度可以降低开关损耗，提高开关电源的效率，特别是在高开关频率下，这一优势将更加明显。

适用于负载/电源开关、电机控制、DC-DC转换和继电器驱动

以上特性使得PXB40HP2系列非常适合对可靠性有一定要求的应用。

体积小巧，耐压高并且拥有相当高的功率容量和较快的开关速度，是您设计中大功率开关电源的理想选择。

负载/电源开关

开关电源

电机控制

DC-DC转换

继电器驱动

高速脉冲放大器

电源转换器电路

逆变器

驱动器